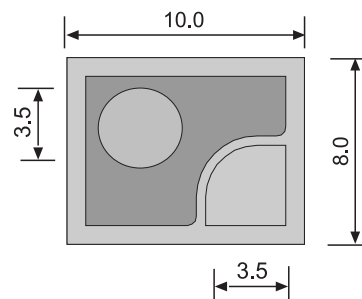


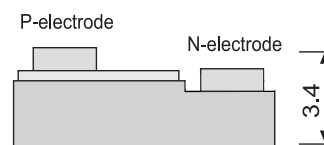
◆ 产品特点:

- 高亮度、长寿命
- 低电流驱动，损耗小
- 芯片百分百测试分选
- 波长和光强良好的一致性



◆ 物理参数:

P电极	金
N电极	金
芯片尺寸	10mil x 8mil (255 ± 15 μm x 200 ± 15 μm)
芯片厚度	3.4mil (85 μm ± 15 μm)
焊盘尺寸	3.5mil (90 ± 10 μm) in diameter



单位: mil

◆ 光电参数: (T_C=22°C, I_F=5mA)

产品型号	波长范围 (λ _D , nm)		工作电压 (V _F , V)	反向漏电流 (I _R , μA) @V _R =10V	半波宽度 (Δλ, nm)	最大电流 (I _F , mA) DC
	Min	Max				
S-10BBAUT*-450E**	450	455	2.70 - 3.1	≤ 2	≤ 30	20
S-10BBAUT*-455E**	455	460				
S-10BBAUT*-460E**	460	465				
S-10BBAUT*-465E**	465	470				
S-10BBAUT*-470E**	470	475				

◆ 光强等级: (T_C=22°C, I_F=5mA)

等级: I _V 范围(mcd)	A1: 8-12	B1: 20-25	...
	A2: 12-16	B2: 25-30	...
	A3: 16-20		...

◆ 其它说明

- 光电参数均系三安光电测试仪器在晶圆条件下测试 98%符合标称值范围
- 芯片封装工艺最高温度低于280°C, 持续时间小于10秒
- GaN LED 芯片为静电敏感产品, 使用、运输时注意静电防护
- 主波长测量误差 ± 1.0nm
- 可根据客户要求订做特殊规格的芯片